PDMS バイアスバネおよび形状記憶合金厚膜を用いた 触覚ディスプレイの開発

Development of tactile display using PDMS bias spring and shape memory alloy thick film

		2221018					
	研究代表者 (助成金受領者)	和歌山工業高等専門学校 知能機械工学科	准教授	徐		嘉	楽
	共同研究者	山形大学 大学院理工学研究科	教 授	峯	Ξ		貴

[研究の目的]

触覚ディスプレイは文字や記号等を再現し, 人間の指先等に提示するツールである。これま で圧力型や電磁型等の様々な駆動手法の触覚 ディスプレイの開発がされてきたが,十分な発 生力や振幅を提示するためにシステムが大きく なってしまう課題がある。

そこで著者らは、モバイル機器への搭載を目 指し、変位および発生力の両立可能な形状記憶 合金 (SMA) アクチュエータおよびバイアス ばねを組み合わせた小型かつ薄型の触覚ディス プレイの実現に取り組んできた。SMA アク チュエータとバイアスばね接合時に精度の高い アライメントが必要となる。高いアライメント 精度を実現することを目的に本研究では、下地 が見えるように透明な PDMS (Polydimethylsiloxane) 膜を均一に形成し, SMA アク チュエータと接合することでアライメント精度 の向上を図るとともに、PDMS 膜厚を調整す ることで、所望の剛性を得る。さらに、従来の 手法ではキャップ層等を樹脂の重ね塗りにより 形成していたが、安価で加工が容易な Cu 基板 を用いて、精密なエッチングによりキャップ層 およびフレーム層を形成することで、プロセス の簡易化を図る。

[研究の内容,成果]

 PDMS バイアスばねの設計,形成および剛 性評価

1.1 PDMS バイアスばねの設計

SMA アクチュエータの高温相および低温相 での反力とバイアスばねの反力のつり合いによ り発生力と振幅を発生する。SMA アクチュ エータの剛性も考慮し,100~150 N/m の剛性 が得られるように PDMS の膜厚を約 10 µm~ 200 µm と異なる数種類のバイアスばねを作製 し、最適膜厚を実験的に選定した。

1.2 PDMS バイアスばねの形成および剛性評価

PDMS バイアスばねの作製プロセスを Fig.1 に示す。犠牲層を形成したダミー基板上に,主 剤および硬化剤を 10:1 の割合で混合した PDMS をスピンコーティング法を用いて PDMS バイアスばねを形成した (Fig.1(a))。 フォトリソグラフィにより樹脂製のマイクロピ ンを PDMS バイアスばね上に形成し (Fig.1 (b)),ダミー基板から剥離し (Fig.1(c)),穴 付きのアクリル治具と接合した (Fig.1(d))。 Fig.2 に示すようにマイクロニードルによりマ イクロピンに変位を与え,反力をフォースゲー ジによって測定した。

PDMS バイアスばね上にピン層を精度良く 一括で形成することができた。PDMS バイア スばねの反力および変位の測定結果を Fig.3 に 示す。作製した膜厚の異なる PDMS バイアス ばねに SMA の初期変位よりも大きい 300 μm の変位を与えてもいずれの PDMS バイアスば ねでも破断等が発生せず,元の形状に回復する ことを確認した。



Fig. 1 Fabrication process of PDMS bias spring for stiffness measurement



Fig. 2 Stiffness measurement of PDMS bias spring



Fig. 3 Stiffness measurement results of PDMS bias spring

PDMS バイアスばねの膜厚が 80 μm~200 μm の場合では,バイアスばねに負荷を加えて 50 μm ずつ,合計 300~400 μm 変位を与え, 除荷した際にヒステリシスが生じることがわ かった。一方で膜厚が約 10 μm~30 μm では, ヒステリシスがほとんど生じず,変位 300 μm 程度では目標となる 150 N/m 程度の剛性が得られることがわかった。

Cu キャップ層およびフレーム層の作製 1 キャップ層の作製

キャップ層およびフレーム層の作製プロセス の簡易化を目指し, Cu 基板の精密なエッチン グによるキャップ層およびフレーム層の形成を 検討した。また, キャップ層およびフレーム層 の段付き構造の形成にも取り組んだ。

キャップ層の作製プロセスを Fig.4 に示す。 研磨した Cu 基板上にレジストをパターンニン グし (Fig.4(a)), Cu 基板を電解エッチングし た (Fig.4(b))。エッチングした表面をレジス トで保護し (Fig.4(c)), 裏面からエッチング により中空構造を形成した (Fig.4(d))。Cap 層の形成結果を Fig.5 に示す。各キャップ層の 開口部は,電解エッチングによりサイドエッチ ングを抑制した 300~400 µm 程度の開口部を 良好に形成することができた。





Fig. 5 Fabricated Cap layer

2.2 フレーム層の形成

キャップ層よりも開口部の広いフレーム層作 製の検討を行った。キャップ層と同様に研磨し た Cu 基板上にレジストをパターンニングし, 電解エッチングを行ったが、Cu 基板が貫通す る前にレジストパターンにクラックが生じるこ とがわかった。次にレジストをパターンニング し (Fig. 6(a)), 硝酸溶液によるエッチングも 試みたが、Cu 基板を貫通する前にレジストの 剥離が生じた (Fig. 6(b))。最後に、電解エッ チングおよび硝酸エッチングを組み合わせた エッチングを試みた。電解エッチングにより深 さ 200 µm 程度をエッチングし、残りの約 200 µm を硝酸エッチングにより、貫通エッチング することで良好に中空構造を形成することがで きた (Fig. 7)。





(a) Resist patterning

(b) After Cu etching

Fig. 6 Cu etching with nitric acid



Fig. 7 Penetration of etching through the Cu frame layer

2.3 キャップおよびフレーム層の段付き構造の形成

作製したキャップ層側にステンシルマスクを 介してエポキシ接着剤を塗布し、フレーム側よ り現物合わせによりアライメントを行い、 キャップ層と接合した(Fig.8)。Fig.8に示す ように良好に接合を行うことができ、Cu キャップおよびフレーム層の段付き構造の形成 プロセスを確立した。

3. SMA アクチュエータの作製

SMA アクチュエータは山形大学の峯田教授 の研究グループによって作製された。SMA ア クチュエータの作製プロセスを Fig.9 に示す。



Fig. 8 Fabricated Cu cap and frame structure

SMA Си (300µm)



(a) SMA flash- (b) Insulator layer (c) Pt film heater evaporation $(7 \sim 10 \ \mu m)$, (1st PI, 2 μm) patterning (100 nm) shape memorization



(d) Au film line patterning (100 nm) (e) SMA electrolytic (f) Cu etching

Fig. 9 Fabrication process of SMA actuator

鏡面研磨した Cu 基板上にフラッシュ蒸着法 により SMA 膜を成膜し,アニール処理をした (Fig. 9(a))。絶縁層をパターンニングし (Fig. 9(b)),スパッタリングにより Pt ヒータ配線 および Au 配線を形成した (Fig. 9(c),(d))。 電解エッチングにより SMA をエッチングした (Fig. 9(e))。最後に Cu 基板を貫通エッチング により,中空構造を形成した (Fig. 9(f))。

PDMS バイアスばねおよび SMA アクチュ エータの接合プロセス

犠牲層を形成したガラス基板上に PDMS 膜 を形成し、酸素プラズマ処理を行い、フォトリ ソグラフィによってピン層を形成した。エッチ ングにより形成した Cu フレーム層と現物合わ せにより位置合わせを行い、ピン付き PDMS バイアスばねおよび Cu フレーム層を接合した。 接合結果を Fig. 10 に示す。Cu フレーム層およ び PDMS バイアスばねの間で剥離することな く,良好に接合することを可能にした。また, フレーム層の開口部中心にピン部を良好に形成 することができた。下地の犠牲層を溶解してガ ラス基板から剥離した。ステンシルマスクを用 いてエポキシ接着剤を SMA アクチュエータ上 に塗布し,PDMS バイアスばね側のピン部か ら下地の SMA アクチュエータの中心部に位置 合わせを行い,接合した。接合結果を Fig. 11 に示す。精度良くマイクロピンおよび SMA ア クチュエータを接合することができ,高いアラ



Fig. 10 After bonding of Cu frame and PDMS bias spring with micro pin



Fig. 11 After bonding of SMA actuator and PDMS bias spring with micro pin

イメント手法を実現することができた。マイク ロピンによる初期変位によって, PDMS バイ アスばねおよび SMA アクチュエータが破断せ ず,変形することを確認した。また,シール構 造になることで防水と防塵の効果で,飛躍的に 触覚ディスプレイの実用化に近づくと考えられ る。

[今後の研究の方向,課題]

所望の剛性を有する透明な PDMS バイアス ばねを形成し、本研究の目的である SMA アク チュエータとバイアスばね接合時の高い精度で の位置合わせ手法の確立は達成できたと考えら れる。また、精密なエッチング手法によりピン 層およびフレーム層の形成手法を確立した。ピ ン層およびフレーム層を接合し、段付き構造を 形成することができた。

今後の方針は PDMS バイアスばねと接合した SMA アクチュエータの動作特性を評価し、 Cu キャップ層側と接合し、人間の指に刺激提示を行い、振動パターンによる刺激知覚について評価を行っていく。

[成果の発表, 論文等]

 ・ 徐嘉楽,天野晏年,峯田貴,"触覚ディスプレイ用 PDMSバイアスばねの形成および剛性評価",第41 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シン ポジウム(発表予定)